

**Japanese Publication for Utility Model
No. 8055-1990 (Jitsukaihei 2-8055)**

A. Relevance of the above-identified Document

This document has relevance to claims 1 and 8 of the present application.

B. Translation of the Relevant Passages of the Document

[WHAT IS CLAIMED IS]

A thin film photosensor, including a sensor thin film transistor and a switching thin film transistor that are formed on a surface of a substrate, wherein a drain electrode of the sensor thin film transistor is connected to a source electrode of the switching thin film transistor via a connection electrode integrated with both the drain and source electrodes, and a capacitor is connected to a drain of the sensor thin film transistor, said thin film photosensor being characterized in that: a capacitor electrode is disposed opposite to the connection electrode, and the capacitor electrode is integrated with a gate electrode of the sensor thin film transistor, and the gate electrode and the source electrode of the sensor thin film transistor are connected to each other.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑫ 公開実用新案公報 (U)

平2-8055

⑬ Int.Cl. 6

H 01 L 27/146
27/01
31/10

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)1月18日

7514-5F

7377-5F H 01 L 27/14
7733-5F 31/10C
E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑭ 考案の名称 薄膜光センサ

⑭ 実 願 昭63-82993

⑭ 出 願 昭63(1988)6月24日

⑮ 考案者 神 原 実 東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会社八王子研究所内

⑯ 出願人 カシオ計算機株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

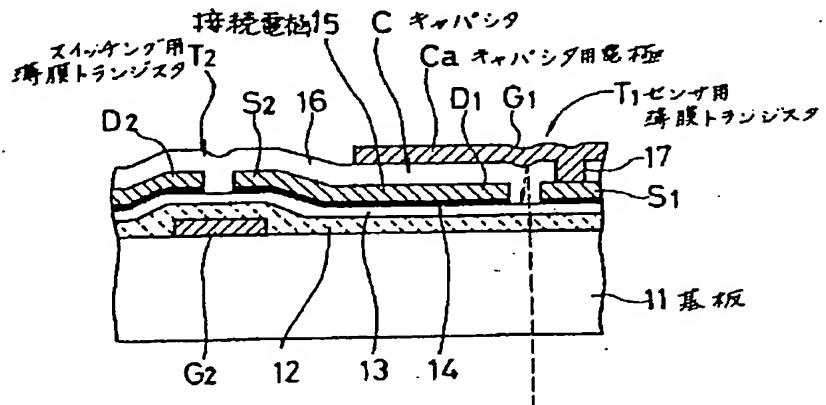
⑯ 代理人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

⑰ 実用新案登録請求の範囲

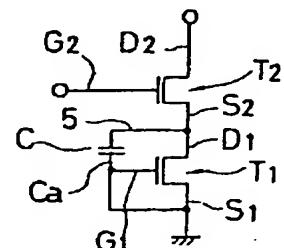
基板面にセンサ用薄膜トランジスタとスイッチング用薄膜トランジスタとを形成するとともに、前記センサ用薄膜トランジスタのドレイン電極と前記スイッチング用薄膜トランジスタのソース電極とをこの両電極と一体の接続電極を介して接続し、かつ前記センサ用薄膜トランジスタのドレインにキヤバシタを接続した薄膜光センサにおいて、前記接続電極と対向させてキヤバシタ用電極を配置し、このキヤバシタ用電極を前記センサ用薄膜トランジスタのゲート電極と一体の電極とするとともに、前記センサ用薄膜トランジスタのゲート電極とソース電極とを接合したことを特徴とする薄膜光センサ。

図面の簡単な説明

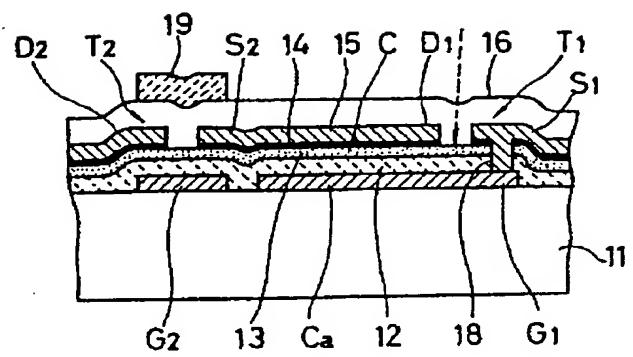
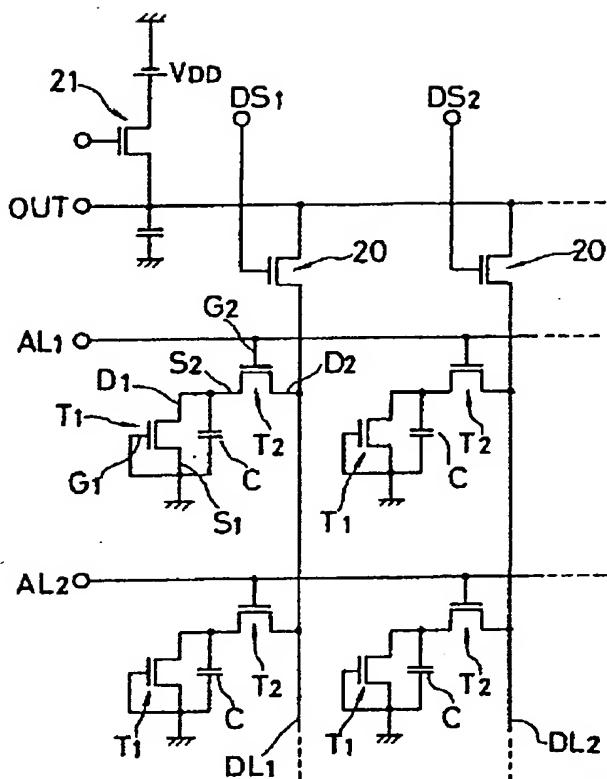
第1図および第2図は本考案の一実施例を示す



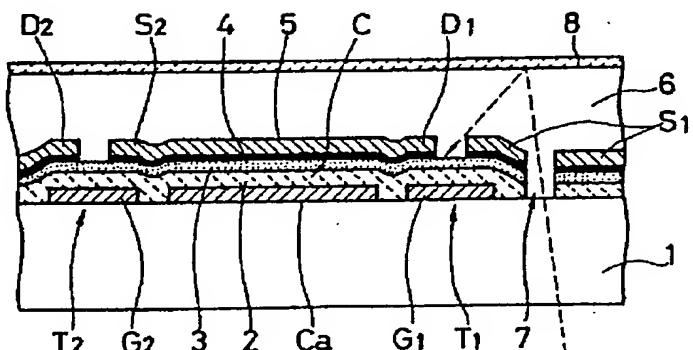
第1図



第2図



第3図



第5図

